チオラート保護金クラスターにおける

異原子ドープ効果の解明:配位子交換能

(東理大院・総合化学) 〇加藤彩乃、江黒真琴、新堀佳紀、藏重亘、根岸雄一

Effect of Foreign Atom Doping to Thiolate-Protected Gold Clusters

for the Ligand Exchange Reaction

(Tokyo Univ. of Sci.) OAyano Kato, Makoto Eguro, Yoshiki Niihori,

Wataru Kurashige, Yuichi Negishi

【序】チオラート保護金クラスターは、他の有機分子によって保護された金属クラスターに比べ安定であり、またバルクの金では見られない、サイズ特異的性質を発現することから、新規機能性ナノ材料としての

応用が期待されている。当研究室では金クラスターの中 でもサイズが小さくかつ安定な Au₂₅(SR)₁₈ に対して異原 子ドープを用いることにより、クラスターにもたらされる物 性の変化について探求してきた。例えば、Pd をドープし たクラスターは、安定性が向上することや反応性を向上 させることが知られている。また、Ag をドープすると発光 波長が変化することや、Cu をドープすると HOMO-LUMO ギャップが減少することが明らかになっ ている。一方、配位子交換反応は、クラスターをチオー ルと反応させ、配位子を他のチオールで置き換える反 応のことである。配位子交換反応を用いて様々な機能 性配位子をクラスターに導入することが可能であると 期待されている。本研究では、クラスターと導入チオー



図 1 各金属クラスターの構造 (a)Au₂₄Pd(SC₂H₄Ph)₁₈, (b)Au_{25-x}Ag_x(SC₂H₄Ph)₁₈, (c)Au_{25-x}Cu_x(SC₂H₄Ph)₁₈



図 2 配位子交換前後のクラスターの MALDI-MS. (a)Au₂₅(SC₂H₄Ph)₁₈ (b)Au₂₄Pd(SC₂H₄Ph)₁₈ (c)Au_{25-x}Ag_x(SC₂H₄Ph)₁₈ (d)Au_{25-x}Cu_x(SC₂H₄Ph)₁₈

ル間での配位子交換反応^[1]の反応速度において、異原子ドープの与える影響を明らかにすることを目的 とした。

【実験】配位子交換反応における反応速度はマトリックス支援レーザー脱離イオン化質量分析 (MALDI-MS)によって評価した。始めに各金属クラスター(Au₂₅(SC₂H₄Ph)₁₈、Au₂₄Pd(SC₂H₄Ph)₁₈、 Au_{25-x}Ag_x(SC₂H₄Ph)₁₈、Au_{25-x}Cu_x(SC₂H₄Ph)₁₈(図1(a)~(c)) 0.1 µmol を 600 µl の CH₂Cl₂に溶かした。 その後、C₈H₁₇SH 50 µmol を加え、任意の反応時間におけるクラスターの MALDI-MS を測定し交換され た配位子数の経時変化を追跡した。

【結果と考察】図 2(a)-(d)に配位子交換前後のクラスターの MALDI-MS を示す。どの金属クラスターの MALDI-MS においても、配位子交換反応前に比べて配位子交換反応後のピークが増加していることに より、配位子交換反応が進行している様子が見て取れる。図3に MALDI-MS によって得られた各クラスタ ーの交換された配位子数の平均値の経時変化を示す。各時間において各金属クラスターの交換された 配位子数の平均値を比較すると、Pdをドープしたクラスターと、Cuをドープしたクラスターが最も配位子が 多く交換されている様子が見て取れる。このことはAu₂₅(SC₂H₄Ph)₁₈に Pd あるいは Cu をドープすると、配 位子交換反応速度が大きくなることを示している。また、Cu に関しては平均ドープ数が大きくなるほど配 位子交換反応速度が大きくなる様子が確認できた。一方、Ag をドープしたクラスターに関しては、Au₂₅ と 反応速度に顕著な違いは確認できなかった。

配位子交換反応は図4のように導入チオールがオリゴマーの金属を攻撃し、導入チオールの硫黄とオ リゴマーの金属間で結合をつくることで反応が開始すると考えられている^[2]。したがって、クラスターの安 定状態での価電子数やクラスター構成金属の電気陰性度、またクラスターの構造が配位子交換反応速 度に影響を与えていると予想される。先行研究により、Au₂₅(SR)₁₈ に Pd をドープすると安定状態での価電

子数が減少し、このことが配位子交換反応速 度の向上につながるということや、Pd はクラス ターの構造に歪みを生じさせ、導入チオール が近づきやすいサイトを生じさせることで配位 子交換を促進させると考えられている^[1]。Auと Ag、Cuの電気陰性度はそれぞれ 2.54、1.90、 1.90 であり、Ag、CuはAuと比較して電気陰性 度が小さいため導入チオールが近づきやすく なっていると考えられる。しかし、近年の精力 的な研究により、Pd は Au₂₅(SR)₁₈のコア中心 部分、Ag はコア表面、Cu はオリゴマー部分に ドープされていることが明らかとなっている(図 1(a)-(c))^[3]。AgとCuは、電気陰性度は同じで あるが、Cu は反応部位であるオリゴマーにド ープされるため、配位子交換反応をより促進さ せていると推察される。一方、Ag は反応部位 ではないコア表面にドープされるため、あまり 配位子交換反応に影響を与えていないと考え られる。また、Cuをドープしたクラスターは、Au とCuの原子半径の違いにより、幾何構造にわ ずかな歪みを生じることも明らかになっている [4]。この歪みが配位子の近づきやすいサイトを 増加させ、配位子交換反応速度を促進させる 要因の一つになっているとも考察される。



図 3 各クラスターの反応時間における平均交換 配位子数の経時変化



[1] Y. Niihori, W. Kurashige, M. Matsuzaki and Y. Negishi, *Nanoscale*, 2013, 5, 508-512
[2] C. L. Heinecke, T. W. Ni, V. Makinen, O. A. Wang, H. Hakkinen and C. J. Ackerson, *J. Am. Soc.* 2012, 134, 13316-13322

[3] S. Yamazoe, W. Kurashige, K. Nobusada, Y. Negishi and T. Tsukuda, J. Phys. Chem. C, 2014, 118, 25284-25290

[4] Y. Negishi, K. Munakata, W. Ohgake, and K. Nobusada, J. Phys. Chem. Lett. 2012, 3, 2209-2214